

日 本 国 特 許 庁  
JAPAN PATENT OFFICE

PCT/JP03/04693

14.04.03

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出 願 年 月 日  
Date of Application:

2002年 4月17日

出 願 番 号  
Application Number:

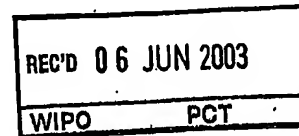
特願2002-114539

[ST.10/C]:

[JP2002-114539]

出 願 人  
Applicant(s):

松下電器産業株式会社



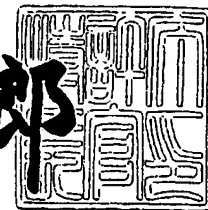
PRIORITY  
DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN  
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

2003年 5月20日

特 許 庁 長 官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

太田信一郎



出証番号 出証特2003-3037115

BEST AVAILABLE COPY

特 2 0 0 2 - 1 1 4 5 3 9

【書類名】 特許願  
【整理番号】 2913040198  
【提出日】 平成14年 4月17日  
【あて先】 特許庁長官殿  
【国際特許分類】 H01L 21/60  
【発明者】  
    【住所又は居所】 大阪府門真市大字門真 1 0 0 6 番地 松下電器産業株式  
                                会社内  
    【氏名】 境 忠彦  
【発明者】  
    【住所又は居所】 大阪府門真市大字門真 1 0 0 6 番地 松下電器産業株式  
                                会社内  
    【氏名】 大園 満  
【発明者】  
    【住所又は居所】 大阪府門真市大字門真 1 0 0 6 番地 松下電器産業株式  
                                会社内  
    【氏名】 和田 義之  
【特許出願人】  
    【識別番号】 000005821  
    【氏名又は名称】 松下電器産業株式会社  
【代理人】  
    【識別番号】 100097445  
    【弁理士】  
    【氏名又は名称】 岩橋 文雄  
【選任した代理人】  
    【識別番号】 100103355  
    【弁理士】  
    【氏名又は名称】 坂口 智康

特2002-114539

【選任した代理人】

【識別番号】 100109667

【弁理士】

【氏名又は名称】 内藤 浩樹

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 011305

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9809938

【書類名】 明細書

【発明の名称】 半導体装置の組立方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 表面に複数の外部接続用端子が形成された半導体素子の裏面にこの半導体素子よりも剛性の高い構造体を樹脂によって接着した半導体装置の組立方法であって、前記構造体となる板状部材に樹脂を供給する第 1 工程と、複数の半導体素子の裏面側を前記樹脂を介して前記板状部材に整列状態で接着する第 2 工程と、前記半導体素子が接着された板状部材を隣接する半導体素子間で切断する第 3 工程を含むことを特徴とする半導体装置の組立方法。

【請求項 2】 前記第 1 工程において、ディスペンサによって前記樹脂を板状部材に塗布することを特徴とする請求項 1 記載の半導体装置の組立方法。

【請求項 3】 前記板状部材の半導体素子接着位置の周囲に前記樹脂の広がりを規制するダム部を設け、このダム部の内側にディスペンサで樹脂を塗布することを特徴とする請求項 2 記載の半導体装置の組立方法。

【請求項 4】 前記第 1 工程において、板状部材にシート状の樹脂を貼り付けることを特徴とする請求項 1 記載の半導体装置の組立方法。

【請求項 5】 前記第 2 工程は、板状部材に供給された樹脂上に複数の半導体素子を搭載する搭載工程と、複数の半導体素子が搭載された板状部材を加熱する加熱工程を含むことを特徴とする請求項 1 記載の半導体装置の組立方法。

【請求項 6】 前記第 2 工程は、板状部材に供給された樹脂上に半導体素子を搭載しながら樹脂を加熱する工程を含むことを特徴とする請求項 1 記載の半導体装置の組立方法。

【請求項 7】 前記第 2 工程において、前記樹脂を半導体素子の側面に這い上がらせることを特徴とする請求項 1 記載の半導体装置の組立方法。

【請求項 8】 前記半導体素子の電極形成面には、再配線層が形成されていることを特徴とする請求項 1 記載の半導体装置の組立方法。

【発明の詳細な説明】

【 0 0 0 1 】

【発明の属する技術分野】

本発明は、半導体素子の裏面にこの半導体素子よりも剛性の高い構造体を樹脂によって接着した半導体装置の組立方法に関するものである。

【0002】

【従来の技術】

半導体素子をパッケージングして製造される電子部品を回路基板に実装する電子部品実装構造として、電子部品に形成された半田バンプなどの突出電極を回路基板に接合した構造が知られている。このような実装構造において、実装後の接合信頼性を実現する上で求められるヒートサイクル時の応力レベルの低減、すなわち実装後の環境温度変化によって半導体素子とワークとの熱膨張率の差に起因して半導体素子と半田バンプとの接合部に発生する応力を低く抑えることを目的として、半導体素子を150  $\mu$ m以下に極力薄くする試みが進行している。

【0003】

本出願人は、薄く加工された半導体素子を組み込んだ新たな半導体装置を提案した（特願2000-335492号）。この半導体装置は、半導体素子の裏面にバンパー（構造体）を樹脂で接合することにより取り扱いを容易にすると同時に、半導体素子自身の変形を許容することにより接合部の応力を分散して接合信頼性を高めることができるといった長所を有している。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、上述の半導体装置の組立方法はまだ確立しておらず、低コストで組立ができる新規な方法が望まれている。

【0005】

そこで本発明は、薄化された半導体素子の裏面に構造体を有する半導体装置を効率よく製造することができる半導体装置の組立方法を提供することを目的とする。

【0006】

【課題を解決するための手段】

請求項1記載の半導体装置の組立方法は、表面に複数の外部接続用端子が形成された半導体素子の裏面にこの半導体素子よりも剛性の高い構造体を樹脂によっ

て接着した半導体装置の組立方法であって、前記構造体となる板状部材に樹脂を供給する第1工程と、複数の半導体素子の裏面側を前記樹脂を介して前記板状部材に整列状態で接着する第2工程と、前記半導体素子が接着された板状部材を隣接する半導体素子間で切断する第3工程を含む。

【0007】

請求項2記載の半導体装置の組立方法は、請求項1記載の半導体装置の組立方法であって、前記第1工程において、ディスペンサによって前記樹脂を板状部材に塗布する。

【0008】

請求項3記載の半導体装置の組立方法は、請求項2記載の半導体装置の組立方法であって、前記板状部材の半導体素子接着位置の周囲に前記樹脂の広がりを規制するダム部を設け、このダム部の内側にディスペンサで樹脂を塗布する。

【0009】

請求項4記載の半導体装置の組立方法は、請求項1記載の半導体装置の組立方法であって、前記第1工程において、板状部材にシート状の樹脂を貼り付ける。

【0010】

請求項5記載の半導体装置の組立方法は、請求項1記載の半導体装置の組立方法であって、前記第2工程は、板状部材に供給された樹脂上に複数の半導体素子を搭載する搭載工程と、複数の半導体素子が搭載された板状部材を加熱する加熱工程を含む。

【0011】

請求項6記載の半導体装置の組立方法は、請求項1記載の半導体装置の組立方法であって、前記第2工程は、板状部材に供給された樹脂上に半導体素子を搭載しながら樹脂を加熱する工程を含む。

【0012】

請求項7記載の半導体装置の組立方法は、請求項1記載の半導体装置の組立方法であって、前記第2工程において、前記樹脂を半導体素子の側面に這い上がらせる。

【0013】

請求項 8 記載の半導体装置の組立方法は、請求項 1 記載の半導体装置の組立方法であって、前記半導体素子の電極形成面には、再配線層が形成されている。

【 0 0 1 4 】

本発明によれば、構造体となる板状部材に樹脂を供給し、半導体素子の裏面側を樹脂を介して板状部材に整列状態で接着した後に、半導体素子が接着された板状部材を隣接する半導体素子間で切断することにより、薄化された半導体素子を構造体に接着した半導体装置を容易に効率よく組み立てることができる。

【 0 0 1 5 】

【発明の実施の形態】

(実施の形態 1)

図 1 ( a ) は本発明の実施の形態 1 の半導体装置の斜視図、図 1 ( b ) は本発明の実施の形態 1 の半導体装置の部分断面図、図 2 は本発明の実施の形態 1 の半導体装置の組立方法の工程説明図、図 3 は本発明の実施の形態 1 の半導体装置に用いられる板状部材の斜視図、図 4 は本発明の実施の形態 1 の半導体装置の組立に使用される電子部品搭載装置の斜視図、図 5 は本発明の実施の形態 1 の半導体装置の組立に使用されるダイシング装置の斜視図、図 6 は本発明の実施の形態 1 の半導体装置の組立に使用されるダイシング装置の部分断面図、図 7 ( a ) は本発明の実施の形態 1 の実装構造の断面図、図 7 ( b ) は本発明の実施の形態 1 の実装構造の部分断面図、図 8 ( a ) は本発明の実施の形態 1 の半導体装置の斜視図、図 8 ( b ) は本発明の実施の形態 1 の半導体装置の平面図である。

【 0 0 1 6 】

まず図 1 を参照して、半導体装置について説明する。図 1 ( a ) 、 ( b ) において、半導体装置 1 は、半導体素子 2 の裏面に樹脂 5 によってパンパ 4 ( 構造体 ) を接着した構成となっており、半導体素子 2 の表面の縁部に沿って形成された複数の外部接続用端子である電極 2 a 上には、パンプ 3 が形成されている。

【 0 0 1 7 】

ここで半導体素子 2 は機械研磨やエッチングなどの方法によって薄化処理が行われた後の状態である。一般に、半導体素子をパンプを介して基板に実装した状態では、半導体素子の厚み寸法が小さいほど実装後の接合信頼性が優れている。

これは、半導体素子 2 と基板の応力の差に起因してバンパ 3 の接合部に応力が集中しようとしても、半導体素子 2 自体が厚さ方向に変形（撓み）を生じることで応力を分散するからである。このため、本実施の形態では、上述のように半導体素子 2 を薄化处理して厚み  $t_1$  が  $10 \sim 150 \mu\text{m}$  の範囲となるように設定し、厚さ方向への変形（撓み）を可能としている。

## 【0018】

薄化处理は、半導体素子 2 の回路形成面の反対面を砥石等を用いた機械研磨によって粗加工を行い、ドライエッチングや薬液によるウェットエッチングで仕上げ加工を行う。機械研磨を行うと裏面に多数のマイクロクラックを有するダメージ層が形成される。このダメージ層は、半導体素子の抗折強度を低下させる要因となるものであるが、仕上げ加工によりこのダメージ層を除去して半導体素子 2 の抗折強度を高めることができる。

## 【0019】

バンパ 4 は、半導体装置 1 の搭載時などのハンドリングにおいて半導体装置 1 を安定して保持することを容易にするとともに、基板などへ実装された後の半導体装置 1 を外力から保護する機能を有するものである。したがってバンパ 4 は、金属やセラミックまたは樹脂などの構造材を、上記機能を満たすような形状、すなわち半導体素子 2 よりも高い剛性を有するような厚み  $t_2$  で、半導体素子 2 の外形よりも大きい外形形状に加工したものが用いられる。

## 【0020】

ここで半導体素子 2 をバンパ 4 に接着する樹脂 5 には、低弾性係数の変形しやすい材質が用いられており、半導体素子 2 の厚み方向への変形を許容した状態で半導体素子 2 をバンパ 4 に接着するようになっている。これにより、半導体装置 1 を基板に実装した状態において、基板の変形状態に応じて半導体素子 2 が追従変形するようになっている。

## 【0021】

図 1 に示すように、樹脂 5 は半導体素子 2 の全周にわたって 4 辺の端部からはみ出しており、はみ出した樹脂 5 a は半導体素子 2 の側面 2 b に沿って這い上がり側面 2 b を部分的に覆うような形状となっている。この側面 2 b を覆う樹脂 5



a は、半導体素子 2 の縁部を補強する補強部を形成している。

【0022】

半導体素子 2 の縁部には、半導体ウェハをダイシングして個片の半導体素子 2 に切り出す際に生じた微小なクラックがそのまま残留しやすく、このクラックから破損を生じる場合がある。側面 2 b を覆う樹脂 5 a は、このような微小なクラックを含んだ半導体素子 2 の縁部を補強するとともに、後述するように半導体装置 1 を基板 1 0 に実装した状態において、基板と半導体素子 2 との熱変形の差によって発生する応力に起因して半導体素子 2 が過剰に変形するのを防止する機能を有する。

【0023】

次に図 2 を参照して、半導体装置 1 の組立方法について説明する。図 2 (a) において、板状部材 6 は半導体装置 1 の一部を構成するバンパ 4 が切り離される前の中間部品である。図 3 に示すように、板状部材 6 の上面には、格子形状に突出した仕切部 6 a が設けられており、仕切部 6 a で囲まれる凹部 6 b は半導体素子 2 が接着される半導体素子接着位置となっている。仕切部 6 a は、後述するように凹部 6 b 内に半導体素子 2 の接着用の樹脂 5 を塗布する際に、樹脂 5 が半導体接着位置を超えて周囲に広がるのを規制するダム部となっている。

【0024】

板状部材 6 の下面の仕切部 6 a に対応する位置には、溝部 6 c が形成されている。溝部 6 c は、厚み寸法  $t_4$  の板状部材 6 の下面側から格子状の溝を切り込んで形成され、これにより上面からの厚み寸法  $t_3$  が  $t_4$  よりも小さい肉薄部となっている。この肉薄部は、板状部材 6 をバンパ 4 に切断分離する際の切断位置と一致している。

【0025】

次に図 2 (b) に示すように、板状部材 6 の各凹部 6 b にはディスペンサ 7 によって樹脂 5 が塗布され、これにより半導体素子 2 接着用の樹脂 5 が供給される (第 1 工程)。この樹脂 5 の塗布において、凹部 6 b の周囲にはダム部としての仕切部 6 a が設けられていることから、樹脂 5 が半導体接着位置を超えて周囲に広がることが防止される。

【0026】

また塗布に際しては、塗布後に半導体素子2によって押し広げられた樹脂5が半導体素子2の端部から外側にはみ出した際に、前述のように半導体素子2の側面2bを覆うのに過不足がないような適正塗布量の樹脂5がディスペンサ7から吐出される。

【0027】

この後、樹脂5が供給された板状部材6は半導体素子接着工程に送られる。この半導体素子接着工程では、図2(c)、(d)に示すように、半導体素子2を板状部材6に塗布された樹脂5上に搭載し(搭載工程)、次いで樹脂5を加熱して(加熱工程)、樹脂5を熱硬化させることによって、複数の半導体素子2の裏面側を樹脂5を介して板状部材6の各凹部6bに整列状態で接着する(第2工程)。

【0028】

この搭載工程において半導体素子2の搭載に用いられる電子部品搭載装置について、図4を参照して説明する。図4において、部品供給テーブル11には半導体素子2が格子状に貼着された粘着シート12が装着されている。部品供給テーブル11の下方には、半導体素子剥離機構13が配設されており、半導体素子剥離機構13を半導体素子剥離機構駆動部14によって駆動することにより、エジクタピン機構13aによって粘着シート12の下面を突き上げ、これにより半導体素子2を搭載ヘッド16によってピックアップする際に、半導体素子2が粘着シート12の上面から剥離される。

【0029】

部品供給テーブル11の側方には基板保持部15が配設されており、基板保持部15上には樹脂供給後の板状部材6が保持されている。部品供給テーブル11および基板保持部15の上方には、搭載ヘッド駆動部19によって駆動される搭載ヘッド16が配設されている。搭載ヘッド16は吸着ノズル8を備えており、粘着シート12から半導体素子2をピックアップし、基板保持部15上の板状部材6に搭載する。

【0030】

部品供給テーブル11の上方にはカメラ17が配設されており、カメラ17は粘着シート12に貼着された半導体素子2を撮像する。カメラ17によって撮像された画像を半導体素子認識部20で認識処理することにより、粘着シート12における半導体素子2の位置が認識される。位置認識結果は制御部21に送られるとともに、半導体素子剥離機構駆動部14に送られる。これにより、搭載ヘッド16による半導体素子2のピックアップ時には、吸着ノズル8およびエジェクタピン機構13aがピックアップ対象の半導体素子2に位置合わせされる。

## 【0031】

基板保持部15の上方にはカメラ18が配設されており、カメラ18は基板保持部15に保持された板状部材6を撮像する。カメラ18によって撮像された画像を搭載位置認識部22で認識処理することにより、板状部材6における半導体素子搭載位置が検出される。位置認識結果は制御部21に送られ、制御部21がこの位置認識結果に基づいて搭載ヘッド駆動部19を制御することにより、搭載ヘッド16による半導体素子2の搭載時には、吸着ノズル8に保持された半導体素子2が検出された搭載位置に位置合わせされる。

## 【0032】

この電子部品搭載装置によって半導体素子2を板状部材6に搭載する際には、図2(c)に示すように、半導体素子2の bumps 3が形成された表面側を吸着ノズル8によって吸着保持し、半導体素子2の裏面を樹脂5に押し付ける。このとき、樹脂5の塗布量に応じて吸着ノズル8による押し付け高さを調整することにより、各半導体素子2の縁部外側(矢印A参照)にはみ出した樹脂5が、半導体素子2の側面2bを這い上がって側面2bを覆うようにする(図1(b)に示す樹脂5a参照)。このときダイシング時のダメージが残留しやすい半導体素子2の裏面側の端部が完全に覆われて補強されていれば、側面2bは完全に覆われていても、または部分的にのみ覆われていてもどちらでも良い。

## 【0033】

本実施の形態では、半導体素子2を1個づつ搭載ヘッド16で樹脂5に押し付けながら搭載するので、一括して搭載(貼り付け)する場合よりも搭載荷重(押し付け力)を小さくできる。よって電子部品搭載装置としては、ダイボンディン

グ装置や、チップマウンター等を流用することができる。

【0034】

このようにして半導体素子2が搭載された板状部材6は加熱炉に送られる。そしてここで所定温度で加熱されることにより、図2(d)に示すように樹脂5が熱硬化する。このとき、各半導体素子2の縁部外側にはみ出した樹脂5は、熱硬化の過程において一時的に粘度低下することにより表面張力によって半導体素子2の側面2bにさらに這い上がり、側面2bを覆った形状のまま硬化する。これにより、樹脂5の硬化後において、図1(b)に示す補強部としての樹脂5aが形成される。そしてこれにより第2工程が完了する。

【0035】

なお上記実施の形態では、半導体素子2の搭載後に板状部材6を加熱炉に送ることにより樹脂5を熱硬化させるようにしているが、搭載ヘッド16として加熱手段を内蔵したものをを用い、半導体素子2を搭載しながら加熱するようにしてもよい。

【0036】

搭載ヘッド16によって加熱する場合には、図2(d)に示す専用の加熱工程を省略してもよく、このようにすれば加熱炉を省略して設備の簡略化を図ることができるという利点がある。ただし、この場合には搭載ヘッド16のタクトタイムが熱硬化時間によって制約されるため、全体の生産性としては搭載工程と加熱工程を別々に行う場合よりも低下する。また、樹脂5として上記実施の形態では熱硬化性の樹脂を用いる例を示しているが、これに変えて熱可塑性の樹脂素材を用いるようにしてもよい。

【0037】

このようにして樹脂5が硬化した板状部材6は切断工程に送られ、ここで図2(e)に示すように、半導体素子2が接着された板状部材6を回転切断刃24aによって隣接する半導体素子2の間の切断位置で切断する(第3工程)。これにより、板状部材6が半導体素子2ごとのバンパ4に切断分離され、半導体装置1の組立が完成する。

【0038】

この切断工程について、図 5、図 6 を参照して説明する。図 5 は、この切断に用いられるダイシング装置を示している。基板固定部 2 3 の上面には、半導体素子 2 が搭載され樹脂硬化が完了した板状部材 6 は基板固定部 2 3 上に載置される。基板固定部 2 3 の上方には、回転切断刃 2 4 a を備えた切断ヘッド 2 4 が配設されており、回転切断刃 2 4 a を回転させながら切断ヘッド 2 4 を X 方向、Y 方向に移動させることにより、板状部材 6 が溝部 6 c に一致した切断位置に沿って切断される。

## 【 0 0 3 9 】

図 6 に示すように、基板固定部 2 3 の上面には板状部材 6 上の半導体素子 2 に対応した位置毎に吸引保持部 2 5 が設けられており、吸引保持部 2 5 の上面には吸引溝 2 5 a が形成されている。吸引溝 2 5 a は、基板固定部 2 3 の内部に設けられた吸引孔 2 3 a に連通しており、吸引孔 2 3 a はさらに真空吸引源 2 6 に接続されている。板状部材 6 の下面を吸引保持部 2 5 に当接させた状態で真空吸引源 2 6 を駆動することにより、板状部材 6 は吸引保持部 2 5 によって吸着保持され、これにより板状部材 6 の位置が固定される。

## 【 0 0 4 0 】

そしてこのようにして位置が固定された板状部材 6 の仕切部 6 a 上に回転切断刃 2 4 a を位置合わせし、回転切断刃 2 4 a を回転させながら下降させることにより、溝部 6 c 内の肉薄部が切断される。このとき、隣接する半導体素子 2 間の間隔よりも刃幅が小さい回転切断刃 2 4 a を用いることにより、板状部材 6 は個片に分離された後のバンパ 4 が半導体素子 2 の端面からはみ出した形状で切断される。したがって、個片分離された半導体装置 1 においては、バンパ 4 の外形は半導体素子 2 の外形よりも大きくなる。

## 【 0 0 4 1 】

またこの切断においては、予め下面に溝部 6 c が形成されていることから、回転切断刃 2 4 a による切断代が小さくなっている。これにより切断工程における回転切断刃 2 4 a の必要下降量を極力小さくすることができ、切断刃下降時に刃先が基板固定部 2 3 に接触して破損する事故を防止することができる。

## 【 0 0 4 2 】

次に上述の半導体装置 1 を基板に実装して成る電子部品実装構造について図 7 を参照して説明する。図 7 (a) に示すように、半導体装置 1 は基板 1 0 の上面に形成された電極 1 0 a にバンプ 3 を半田接合して接続することにより基板 1 0 に実装される。図 7 (b) は、バンプ 3 から外側に位置する半導体素子 2 の変形状態を示している。本実施の形態に示すような薄化された半導体素子 2 をバンプ 3 を介して基板 1 0 に接合した構造では、半導体素子 2 と基板 1 0 の熱変形の差によって発生する応力に起因して、バンプ 3 から外側の範囲は基板 1 0 側に大きく撓む傾向にある（破線で示す半導体素子 2 参照）。そしてこの変形に伴ってバンプ 3 の外側近傍の半導体素子 2 の下面には高いレベルの表面応力が生じ、半導体素子 2 を破損させる原因となる場合がある。

## 【 0 0 4 3 】

これに対し、本実施の形態に示すように、半導体素子 2 の側面 2 b を覆う樹脂 5 a によって補強された半導体装置 1 を基板 1 0 に実装した場合には、最外周のバンプ 3 から外側の範囲における半導体素子 2 の下方への撓みは大幅に低減される。すなわち、樹脂 5 a は半導体素子 2 の側面 2 b を覆って半導体素子 2 の過度の曲げ変形を防止するように作用する。そしてこの作用により、半導体素子 2 の下方への撓み変形が防止され、半導体素子 2 の曲げ変形による破損を防止することができる。

## 【 0 0 4 4 】

なお、図 8 に示す半導体装置 1 A のように、半導体素子 2 の縁部からの樹脂 5 a のはみ出しを半導体素子 2 の対角線方向に限定し、樹脂 5 a で半導体素子 2 の側面を覆う補強部を、半導体素子 2 の角部のみに形成するようにしてもよい。この場合には、図 2 (b) においてディスペンサ 7 によって樹脂 5 を塗布する際に、図 8 (b) に示す範囲のみに樹脂 5 を塗布するように、ディスペンサ 7 の塗布軌跡を X 字状に設定するとともにディスペンサ 7 からの吐出量を制御する。このように補強部の形成範囲を半導体素子 2 の角部に限定することにより、半導体装置完成後の実装状態において最も破損が生じやすい角部を集中的に補強することができる。

## 【 0 0 4 5 】

## (実施の形態 2)

図 9 は本発明の実施の形態 2 の半導体装置の組立方法の工程説明図である。本発明の実施の形態 2 では、板状部材に樹脂を供給する第 1 工程において、ディスペンサを用いずに予めシート状に形成された樹脂を貼着するものである。

## 【0046】

図 9 (a) において、板状部材 6 A は実施の形態 1 に示す板状部材 6 の上面の仕切部 6 a を除去した形態となっており、板状部材 6 A の下面には同様の溝部 6 c が形成されている。板状部材 6 A の上面には、樹脂シート 5 A が貼着される。樹脂シート 5 A は、実施の形態 1 において用いた樹脂 5 と同様の樹脂素材を粘着シート状に成形したものであり、樹脂 5 自体の粘着性によって板状部材 6 A に貼着される。

## 【0047】

この後、樹脂シート 5 A が貼着された板状部材 6 は半導体素子接着工程に送られる。この半導体素子接着工程では、図 9 (b)、(c) に示すように、半導体素子 2 を板状部材 6 に貼着された樹脂シート 5 A 上に搭載し (搭載工程)、次いで樹脂シート 5 A を加熱して (加熱工程)、樹脂シート 5 A の樹脂成分を熱硬化させることによって、複数の半導体素子 2 の裏面側を熱硬化した樹脂シート 5 A を介して板状部材 6 に整列状態で接着する (第 2 工程)。

## 【0048】

上述の加熱工程においては、加熱炉によって所定温度で加熱されることにより、樹脂シート 5 A の樹脂成分が熱硬化する。このとき、各半導体素子 2 の縁部外側に位置している樹脂 5 は熱硬化の過程において一時的に粘度が低下し、これにより流動性が増して表面張力によって半導体素子 2 の側面 2 b に這い上がる。そしてさらに加熱を継続することにより、樹脂シート 5 A の樹脂成分は側面 2 b を覆った形状のまま硬化する。これにより、樹脂シート 5 A の硬化後において、図 1 (b) に示す補強部としての樹脂 5 a が形成される。そしてこれにより第 2 工程が完了する。

## 【0049】

このようにして樹脂シート 5 A が完全硬化した板状部材 6 A は切断工程に送ら

れ、ここで半導体素子 2 が接着された板状部材 6 A を、隣接する半導体素子 2 の間で切断する（第 3 工程）。これにより、板状部材 6 A が半導体素子 2 毎のパンパ 4 に切断分離され、半導体装置 1 の組立が完成する。

【 0 0 5 0 】

（実施の形態 3）

図 1 0 （ a ）は本発明の実施の形態 3 の半導体装置の斜視図、図 1 0 （ b ）は本発明の実施の形態 3 の半導体装置の部分断面図である。

【 0 0 5 1 】

図 1 0 （ a ）において、半導体装置 1 B は再配線層付半導体素子 3 0 の裏面に樹脂 5 によってパンパ 4 （構造体）を接着した構成となっており、再配線層付半導体素子 3 0 の表面にはパンプ 3 が格子状に複数形成されている。図 9 （ b ）に示すように、再配線層付半導体素子 3 0 は、実施の形態 1 に示す半導体素子 2 と同様に薄化处理された半導体素子 2 A の上面（電極形成面）に再配線層 9 を形成した構成となっている。

【 0 0 5 2 】

半導体素子 2 A の表面の縁部には、外部接続用端子である電極 2 a が形成されており、各電極 2 a は再配線層 9 の表面に電極 2 a に対応した個数だけ形成された電極 9 a と、内部配線 9 b によって導通している。そして電極 9 a 上には、半導体装置 1 B を実装するためのパンプ 3 が形成されている。

【 0 0 5 3 】

本実施の形態 3 では、再配線層 9 を設けることにより、実施の形態 1 に示す半導体装置 1 と比較して、同一投影面積内により多数のパンプ 3 を形成することができ、より高密度の実装が可能となっている。この半導体装置 1 B を組み立てるには、実施の形態 1、2 に示す半導体装置の組立方法において、半導体素子 2 を再配線層付半導体素子 3 0 に置き換えればよい。

【 0 0 5 4 】

これにより、再配線層付半導体素子 3 0 の側面 3 0 a には、はみ出した樹脂 5 a が側面 3 0 a を覆った補強部が形成される。このような構成の半導体装置 1 B において、再配線層付半導体素子 3 0 の側面 3 0 a を覆った補強部を形成するこ



とにより、前述のように実装後に再配線層付半導体素子30の縁部に生じる曲げ変形が防止され、再配線層9内の内部配線9bの破断を防止することができる。

【0055】

【発明の効果】

本発明によれば、構造体となる板状部材に樹脂を供給し、半導体素子の裏面側を樹脂を介して板状部材に整列状態で接着した後に、半導体素子が接着された板状部材を隣接する半導体素子間で切断するようにしたので、薄化された半導体素子を構造体に接着した半導体装置を容易に効率よく組み立てることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

(a) 本発明の実施の形態1の半導体装置の斜視図

(b) 本発明の実施の形態1の半導体装置の部分断面図

【図2】

本発明の実施の形態1の半導体装置の組立方法の工程説明図

【図3】

本発明の実施の形態1の半導体装置に用いられる板状部材の斜視図

【図4】

本発明の実施の形態1の半導体装置の組立に使用される電子部品搭載装置の斜視図

【図5】

本発明の実施の形態1の半導体装置の組立に使用されるダイシング装置の斜視図

【図6】

本発明の実施の形態1の半導体装置の組立に使用されるダイシング装置の部分断面図

【図7】

(a) 本発明の実施の形態1の実装構造の断面図

(b) 本発明の実施の形態1の実装構造の部分断面図

【図8】

(a) 本発明の実施の形態 1 の半導体装置の斜視図

(b) 本発明の実施の形態 1 の半導体装置の平面図

【図 9】

本発明の実施の形態 2 の半導体装置の組立方法の工程説明図

【図 1 0】

(a) 本発明の実施の形態 3 の半導体装置の斜視図

(b) 本発明の実施の形態 3 の半導体装置の部分断面図

【符号の説明】

1, 1 A, 1 B 半導体装置

2, 2 A 半導体素子

2 a 電極

2 b 側面

3 バンプ

4 バンパ

5 樹脂

5 A 樹脂シート

6 板状部材

6 a 仕切部

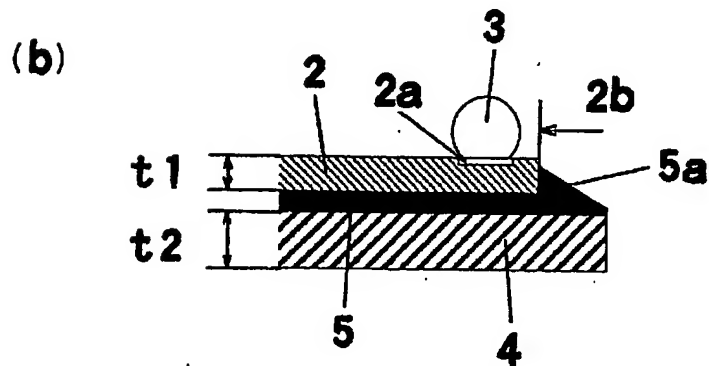
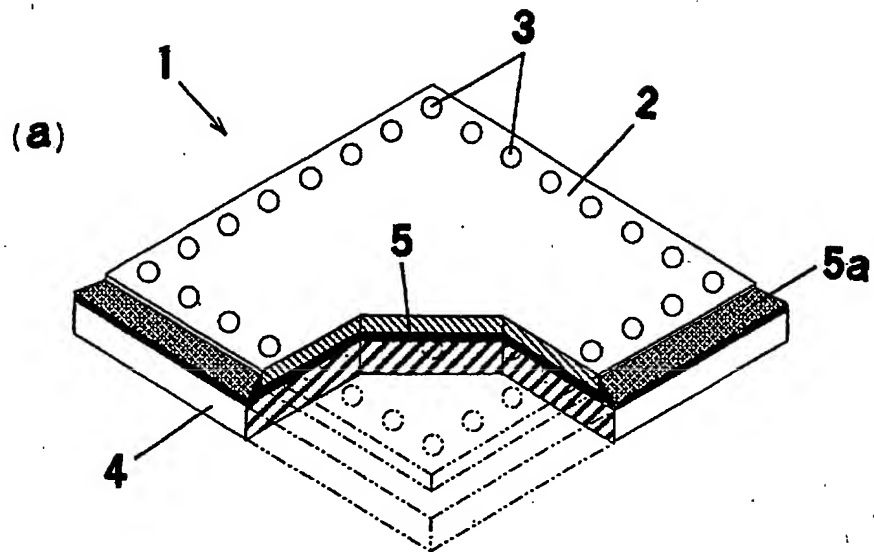
6 b 凹部

7 ディスペンサ

【書類名】

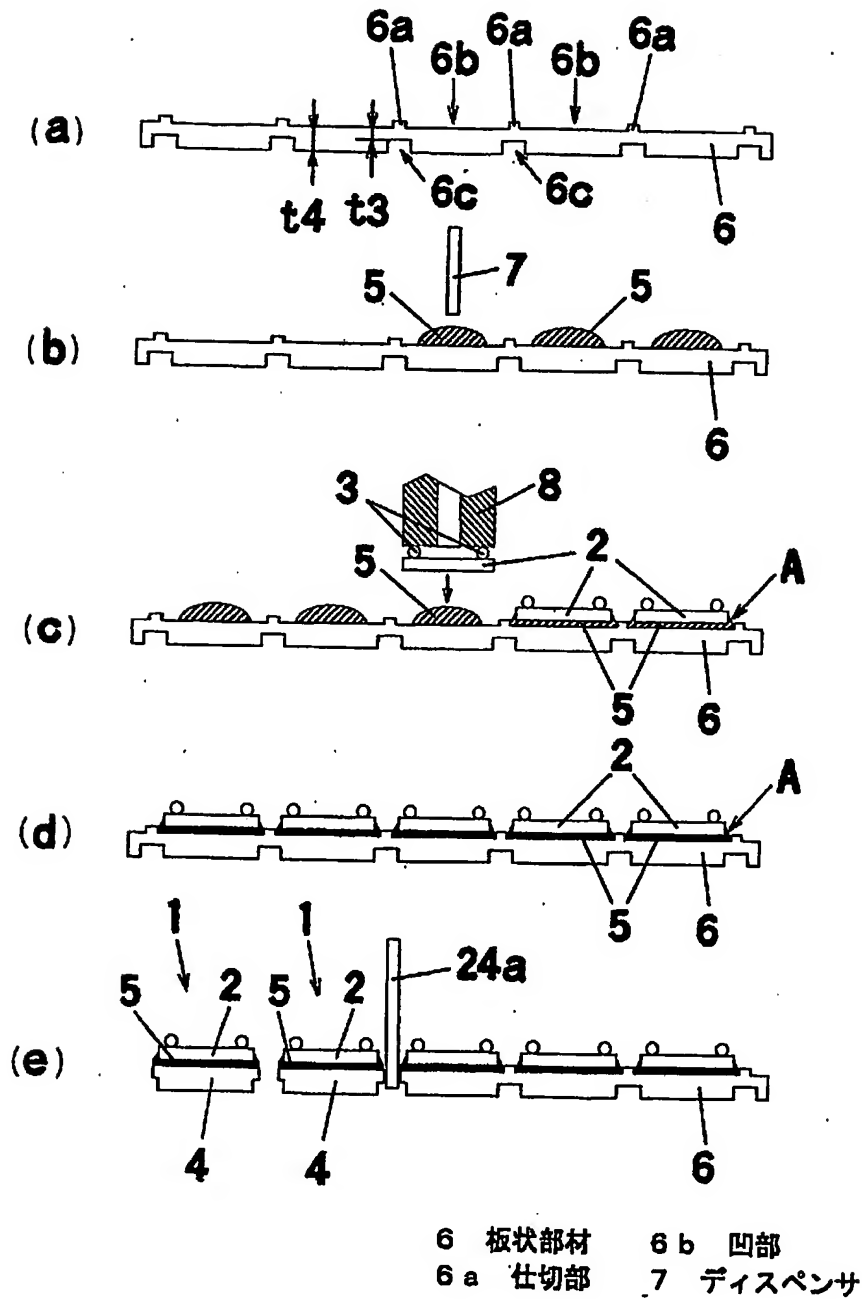
図面

【図1】

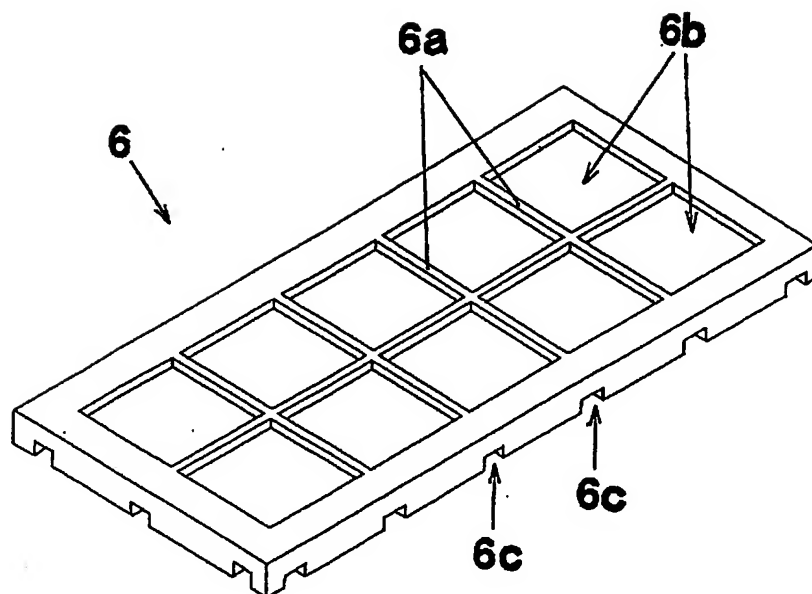


- |         |       |
|---------|-------|
| 1 半導体装置 | 3 パンプ |
| 2 半導体素子 | 4 パンパ |
| 2a 電極   | 5 樹脂  |
| 2b 側面   |       |

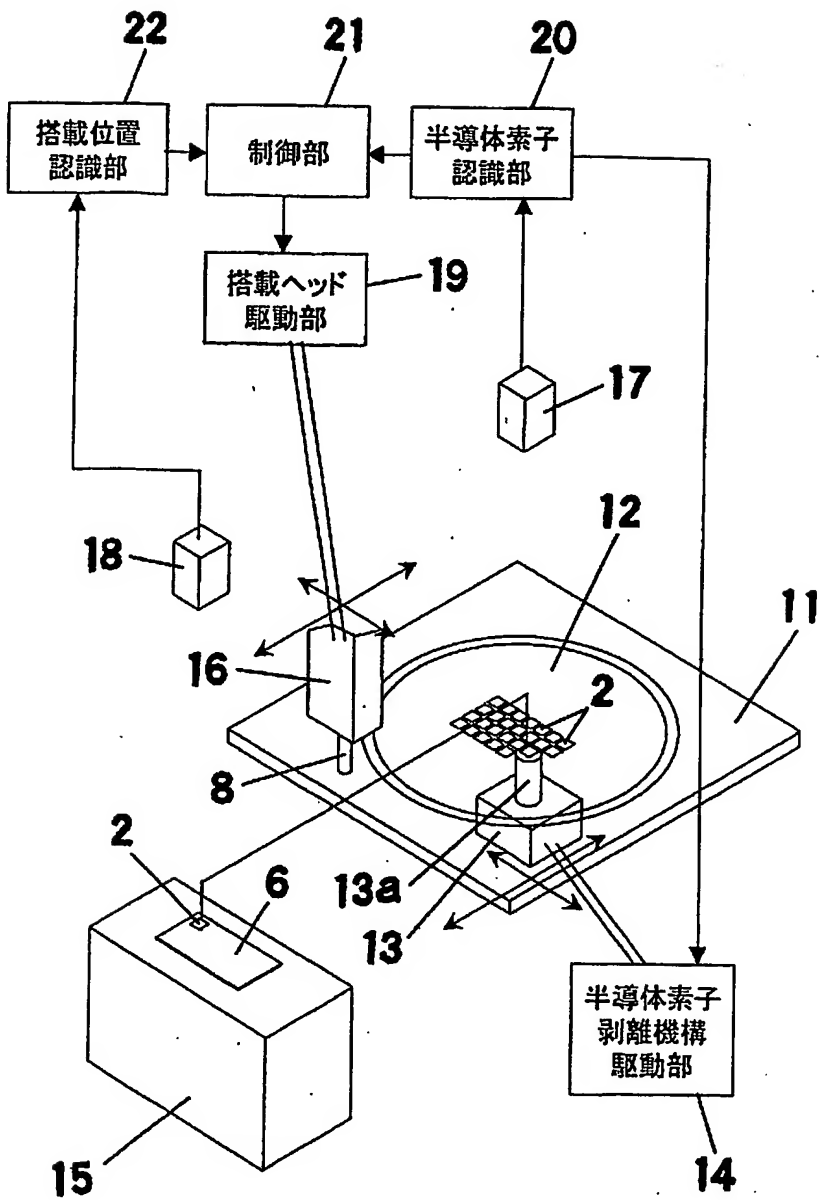
【図2】



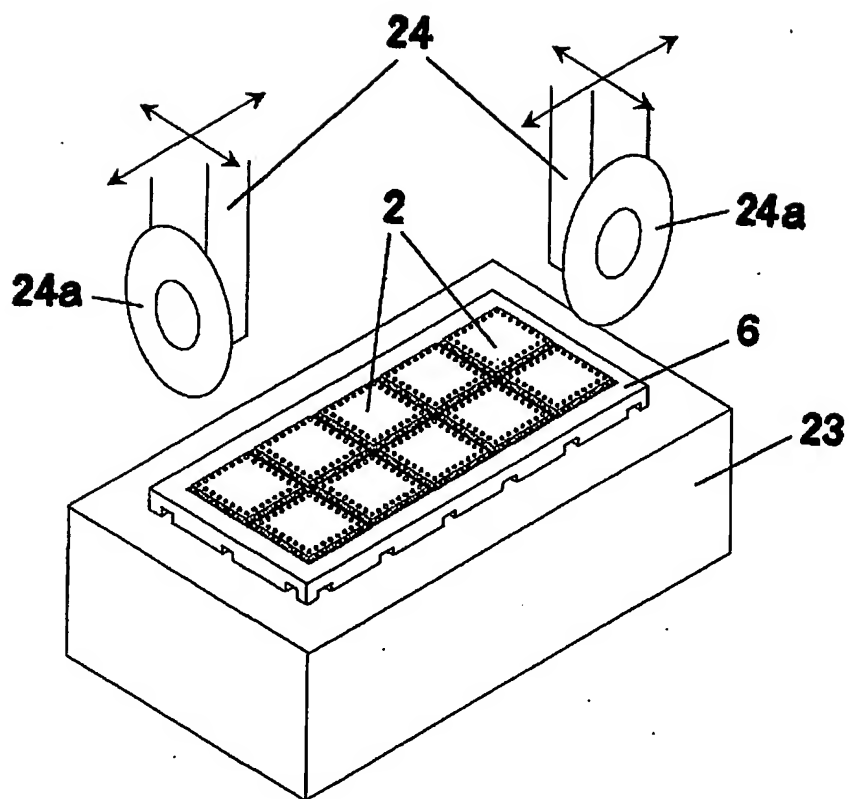
【図3】



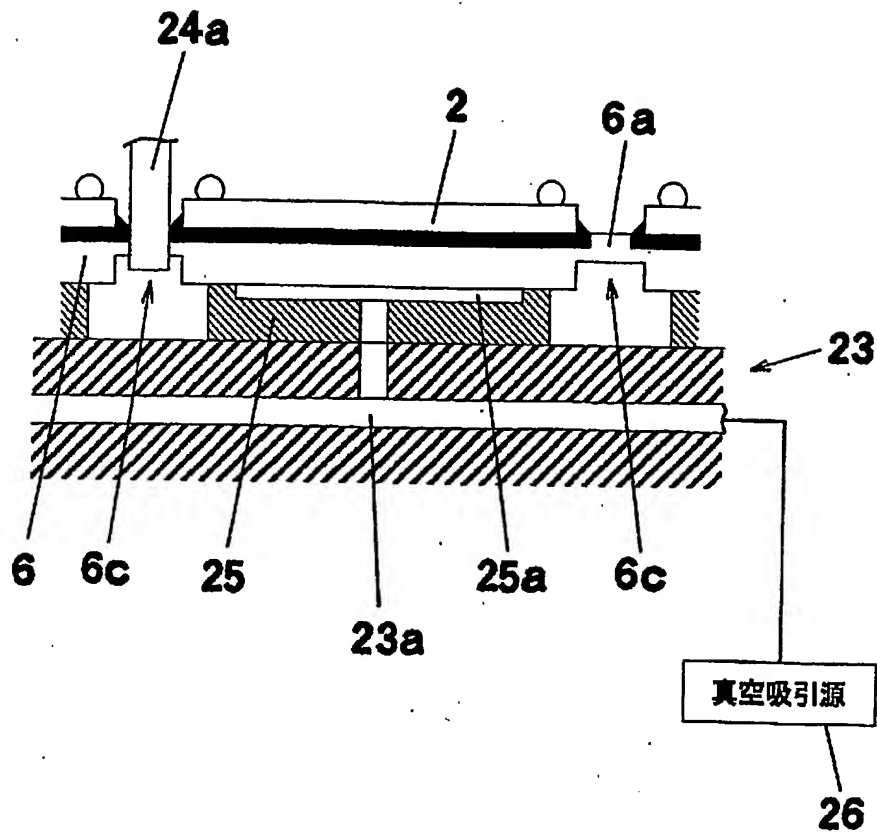
【图4】



【図5】

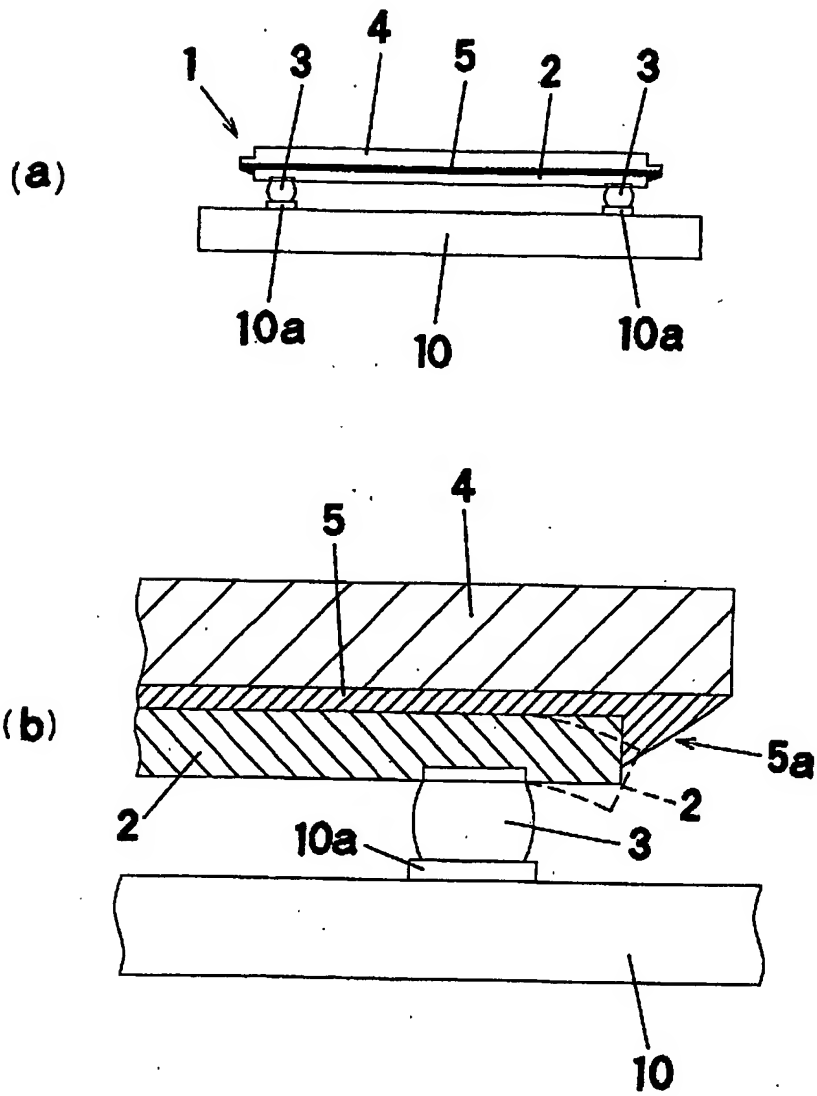


【図6】

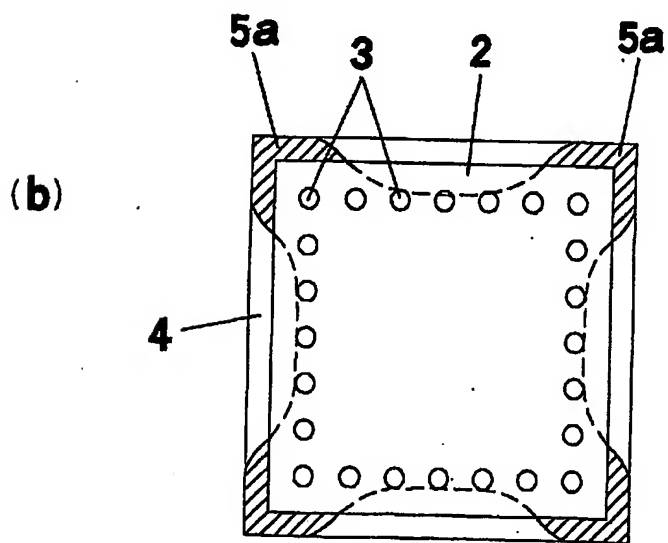
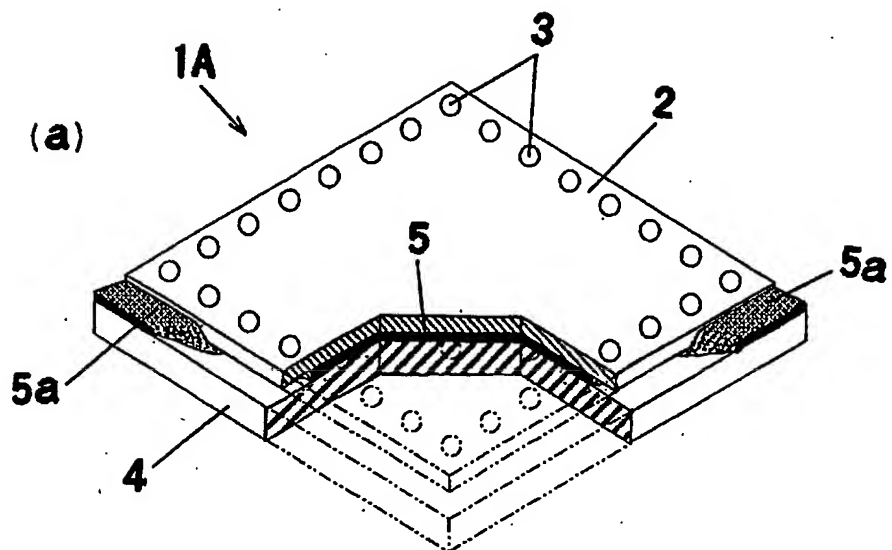




【図7】

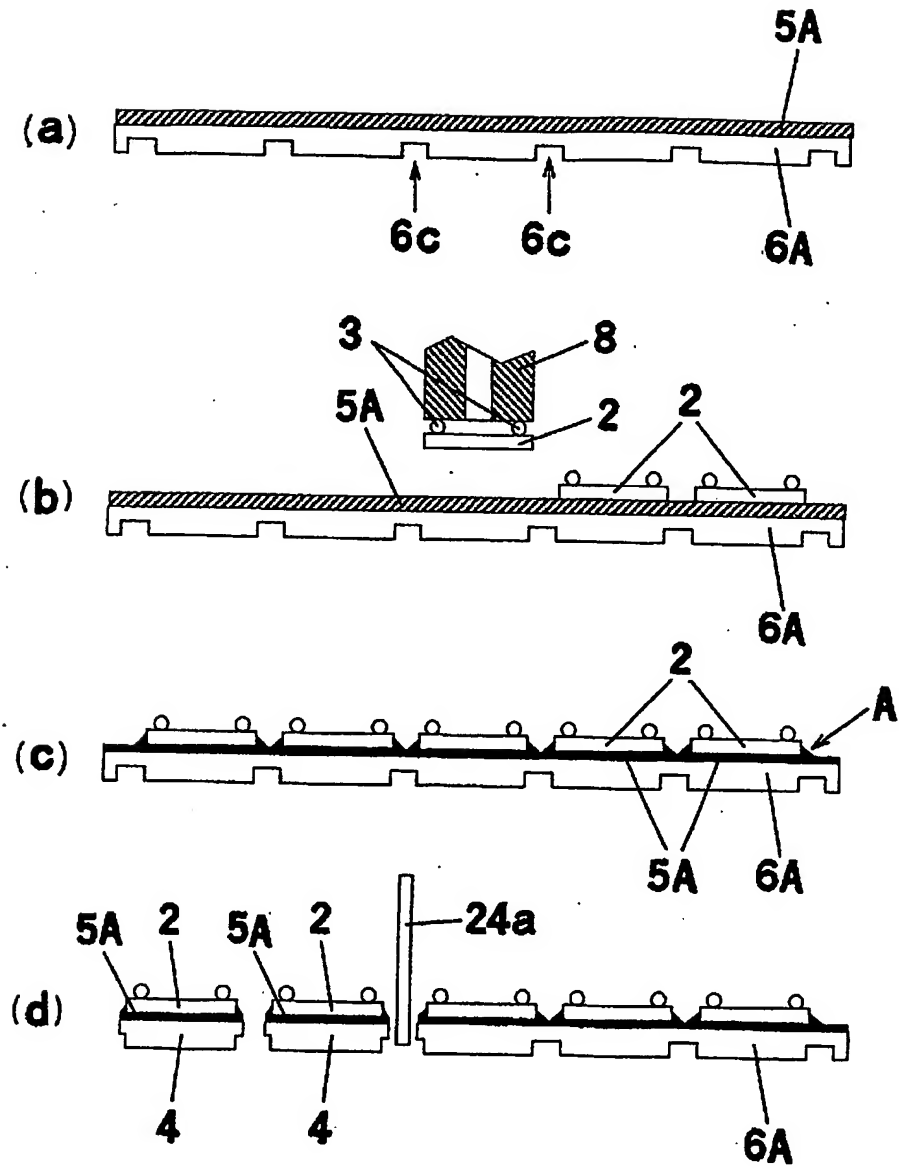


【図8】



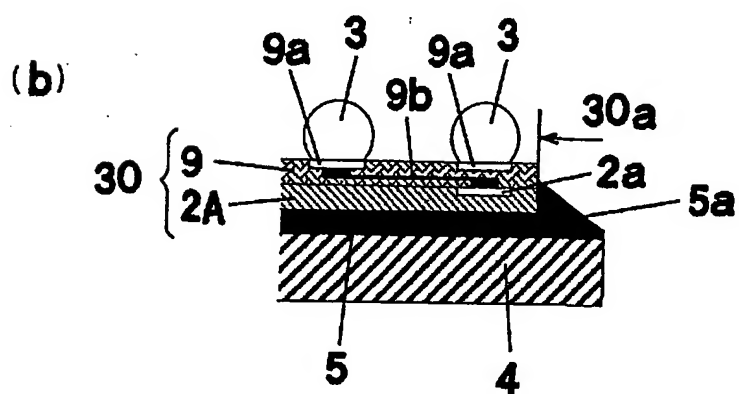
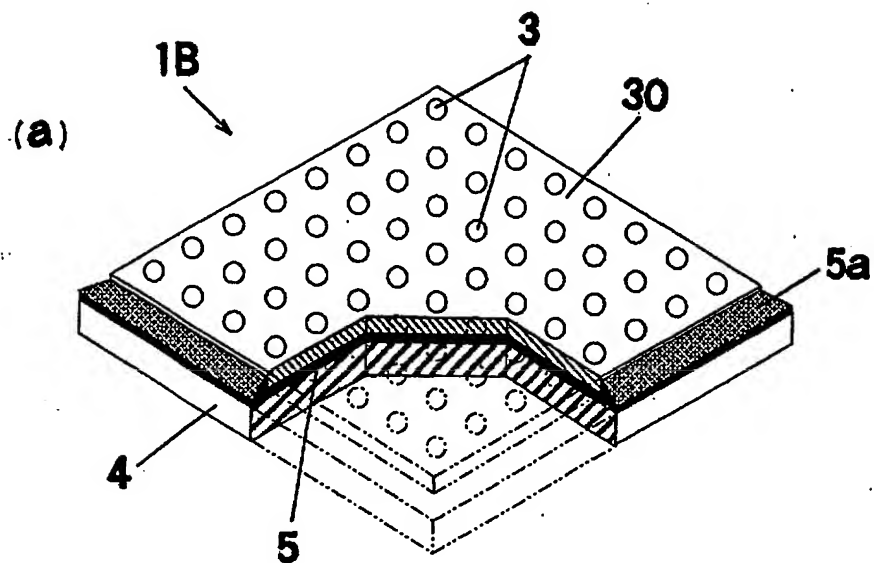
1A 半導体装置

【図9】



5A 樹脂シート

【図10】



1B 半導体装置  
2A 半導体素子

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 薄化された半導体素子の取り扱いが簡単な半導体装置を効率よく製造することができる半導体装置の組立方法を提供することを目的とする。

【解決手段】 半導体素子 2 の表面に形成された外部接続用端子にバンパ 3 を形成し、裏面に保護用のバンパ 4 を樹脂 5 によって接着した半導体装置 1 の組立において、板状部材 6 に樹脂 5 を供給し複数の半導体素子 2 の裏面側を樹脂 5 を介して板状部材 6 に整列状態で接着した後に、板状部材 6 を隣接する半導体素子 2 間で切断して半導体装置 1 に分離する。これにより、薄化された半導体素子 2 をバンパ 4 に接着した半導体装置 1 を容易に効率よく組み立てることができる。

【選択図】 図 2

特2002-114539

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000005821]

1. 変更年月日	1990年 8月28日
[変更理由]	新規登録
住 所	大阪府門真市大字門真1006番地
氏 名	松下電器産業株式会社

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**